

平成28年度入学者選抜試験問題
山形大学大学院理工学研究科博士前期課程
(平成27年8月実施)

【電気電子工学専攻】

専門科目 2

(電子物性と量子物理)

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. この問題冊子の本文は、1ページから2ページまでです。
3. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの乱丁・落丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせて下さい。
4. 監督者の指示に従って、解答用紙の受験番号欄に受験番号を正しく記入して下さい。
5. 解答用紙のおもて面には、既に受験科目名と問題番号が記入されています。解答は解答用紙のおもて面の所定の位置に記入してください。
6. 必要に応じて計算過程も記入して下さい。
7. 解答用紙は白紙も含めてすべて提出して下さい。
8. 試験終了後、問題冊子及び草案用紙は持ち帰って下さい。

専門科目 2：電子物性と量子物理

解答は導出過程も示すこと。数値を求める問題では有効数字 3 桁で解答し、単位も明記せよ。必要に応じて次の物理定数を用いること。なお、 π は 3.141592 とする。

真空中の光速	$c = 2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$	ボルツマン定数	$k_B = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
アボガドロ数	$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	真空の透磁率	$\mu_0 = 1.257 \times 10^{-6} \text{ H m}^{-1}$
プランク定数	$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$	電子の静止質量	$m_0 = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
真空の誘電率	$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$	電子の電荷	$-e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

1. 以下の問いに答えよ。

- (1) 波長が $1.20 \mu\text{m}$ の光子(フォトン)1 個のエネルギーを eV と J の単位で求めよ。
- (2) 静止状態から 10.0 kV で加速された電子のドブロイ波の運動量と波長を求めよ。
電子の質量は静止時の質量と等しいと仮定してよい。
- (3) アルミニウム 1.00 kg の温度を 10.0°C から 15.0°C に上げるのに必要なエネルギーを求めよ。アルミニウムの比熱は 0.900 J/gK とする。
- (4) 直径 1.00 mm で長さ 10.0 m の導体の抵抗が 2.00Ω であった。この導体の導電率を求めよ。この導体のキャリア密度が、 $8.00 \times 10^{22}/\text{cm}^3$ であるときに、キャリア移動度を求めよ。

2. 鉄やリチウムなどの結晶の単位格子(単位胞)は図 1 で示される。以下の問いに答えよ。

- (1) この結晶構造名を答えよ。
- (2) この単位格子に含まれる原子数を答えよ。
- (3) この結晶構造の原子の充填率を求めよ。
- (4) この結晶の格子定数が a_0 であるときに、(211)面の面間隔 d_1 を求めよ。
- (5) X線回折において、(211)面から得られる回折角を θ_1 とするときに、 θ_1 と面間隔 d_1 の関係を求めよ。このとき X 線の波長は λ とする。

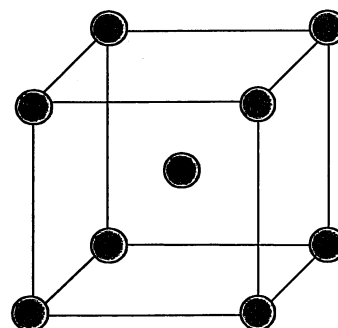


図 1 鉄やリチウムなどの単位格子

3. 半導体中の自由電子密度を n 、ホール密度を p としたときに、 n 、 p はそれぞれ

$$n = N_c \cdot \exp\left(\frac{E_f - E_c}{k_B T}\right), \quad p = N_v \cdot \exp\left(\frac{E_v - E_f}{k_B T}\right)$$

で表される。この式において、 N_c 、 N_v はそれぞれ伝導帯と価電子帯の有効状態密度、 E_f はフェルミエネルギー、 E_c 、 E_v はそれぞれ伝導帯の底と価電子帯上端のエネルギー、 k_B はボルツマン定数、 T は絶対温度である。以下の問いに答えよ。

- (1) バンドギャップを E_g としたときに、真性キャリア密度 n_i を求めよ。
- (2) この半導体にアクセプタとなる原子を濃度 N_a でドーピングした。アクセプタ原子がすべてイオン化したときの、この半導体の自由電子密度 n を真性キャリア密度 n_i とドーピング濃度 N_a で表せ。

4. 図2に示すような一次元の階段ポテンシャル($V(x) = 0$ (領域 I: $x < 0$), $V(x) = V_0$ (領域 II: $x \geq 0$))がある。ここで質量 m の電子が領域 I から、領域 II に、運動エネルギー E_0 ($E_0 > V_0$) で移動する。

- (1) 領域 I と領域 II での電子のシュレーディンガー方程式をそれぞれ書け。電子の波動関数は ϕ 、ディラック定数を $\hbar (= \frac{h}{2\pi})$ とする。

- (2) 領域 I での電子の波数 k_1 と領域 II での電子の波数 k_2 を求めよ。

- (3) 領域 I における電子の波動関数を ϕ_1 、領域 II における電子の波動関数を ϕ_2 とするときに、波動方程式の一般解は次のように与えられる。

$$\phi_1 = Ae^{ik_1 x} + Be^{-ik_1 x} \quad (\text{領域 I})$$

$$\phi_2 = Ce^{ik_2 x} + De^{-ik_2 x} \quad (\text{領域 II})$$

与えられた条件から、領域 II において反射は起こらないので、 $D=0$ である。 A 、 B と C の関係式を二つ示せ。

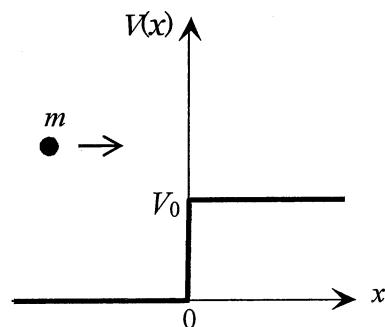


図2 一次元階段ポテンシャル